**Технические характеристики транзисторов КТ920А, КТ920Б, КТ920В, КТ920Г:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типтранзистора | Структура | Предельные значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | TПmax | Тmax |
| IКmax | IК. И.max | UКЭR max | UКБ0 max | UЭБ0 max | UПИТ max | РК max | h21Э | UКЭнас. | IКЭR | IКБО | f гp. | PВЫХ | КУР |
| А | А | В | В | В | В | Вт |  | В | мА | мА | МГц | Вт | дБ | °С | °С |
| **КТ920А** | n-p-n | 0,25 | 1 | 36 | - | 4 | 12,6 | 5 | - | - | <2 | - | >400 | 2 | 7 | 150 | -45…+85 |
| **КТ920Б** | n-p-n | 1 | 2 | 36 | - | 4 | 12,6 | 10 | - | - | <4 | - | >400 | 5 | 4,5 | 150 | -45…+85 |
| **КТ920В** | n-p-n | 3 | 7 | 36 | - | 4 | 12,6 | 25 | - | - | <7,5 | - | >400 | 20 | 3 | 150 | -45…+85 |
| **КТ920Г** | n-p-n | 3 | 7 | 36 | - | 4 | 12,6 | 25 | - | - | <7,5 | - | >400 | 15 | 5 | 150 | -45…+85 |

КТ920Б
Транзисторы КТ920Б кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n генераторные.
Предназначены для применения в усилителях мощности, умножителях частоты и автогенераторах на частотах 50...200 МГц при напряжении питания 12,6 В.
Используются для работы в бортовой аппаратуре подвижных средств радиосвязи общего назначения.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами и монтажным винтом.
Маркируются цифро-буквенным кодом на корпусе транзистора.
Масса транзистора не более 4,5 г.
Тип корпуса: КТ-17.
Вид климатического исполнения: «УХЛ».
Категория качества: «ОТК».
Технические условия:
  - приемка «1» - аА0.336.059ТУ.
Импортный аналог: 2N6080, BLW18, 2SC2066.

Основные технические характеристики транзистора КТ920Б:
• Структура транзистора: n-p-n;
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 10 Вт;
• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: более 400 МГц;
• Uкбо max - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 36 В;
• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 1 А;
• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 2 А;
• Iкэr - Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база-эмиттер: не более 4 мА (36В);
• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 25 пФ;
• Ку.р. - Коэффициент усиления мощности: не менее 4,5 дБ;
• Рвых - Выходная мощность транзистора: не менее 5 Вт на частоте 175 МГц;
• tк - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 20 пс

**Условные обозначения электрических параметров транзисторов:**
• **IК max** - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
• **IК. И. max** - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
• **UКЭR max** - максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при сопротивлении в цепи база-эмиттер.
• **UКЭ0 max** - максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при токе базы, равном нулю.
• **UКБ0 max** - максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база при токе эмиттера, равном нулю.
• **UЭБ0 max** - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
• **UПИТ max** - максимально допустимое напряжение питания.
• **РК max** - максимально допустимая постоянная мощность, рассеивающаяся на коллекторе транзистора.
• **РК. Т. max** - максимально допустимая постоянная мощность, рассеивающаяся на коллекторе транзистора с теплоотводом.
• **h21Э** - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
• **UКЭ нас.** - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
• **IКЭR** - обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база- эмиттер.
• **IКБО**- обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
• **IЭБО**- обратный ток эмиттера. Ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер-база и разомкнутом выводе коллектора.
• **f гр** - граничная частота коэффициента передачи тока.
• **PВЫХ** - выходная мощность транзистора.
• **КУР** - коэффициент усиления по мощности транзистора.
• **ТП max** - максимально допустимая температура перехода.
• **Т max** - максимально допустимая температура окружающей среды.